

## LTK5131 2Ω11W、防破音\_F类、单声道音频放大器

### ■ 概述

LTK5131 是一款 2Ω-11W、防破音单端输入单声道 F 类音频功率放大器。LTK5131 采用高耐压工艺，耐压可达 7.5V，LTK5131 具有一线脉冲功能只需使用一个 IO 口，可控制功放开启、关闭、D 类防破音模式、D 类普通模式、AB 类模式的随意切换，为用户达到节省 IO 口的目的，如不使用一线脉冲功能，也可分别控制 EN 和 MODE 管脚，方便地切换为各个工作模式，AB 类模式下能解决传统 D 类功放对 FM 的干扰问题，完全消除 EMI 干扰。在 D 类放大器模式下可以提供高于 90% 的效率，新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大器的输出低通滤波器。LTK5131 采用 ESOP-8 封装。

### ■ 应用

- 蓝牙音箱、智能音箱
- 导航仪、便携游戏机
- 拉杆音箱、DVD、扩音器、MP3、MP4
- 智能家居等各类音频产品

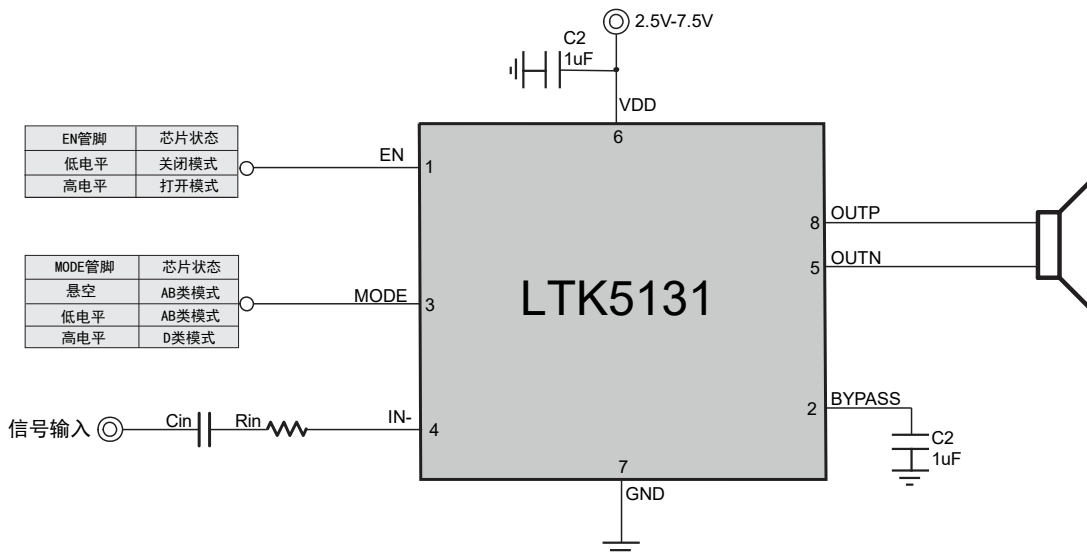
### ■ 特性

- 输入电压范围 2.5V-7.5V
- 一线脉冲控制
- 2 种防破音模式
- 无滤波的 D 类/AB 类放大器、低静态电流和低 EMI
- FM 模式无干扰
- 优异的爆破声抑制电路
- 超低底噪、超低失真
- 10% THD+N, VDD=7V, 2Ω+15uH 负载下提供高达 11W 的输出功率
- 10% THD+N, VDD=7V, 4Ω+33uH 负载下提供高达 6.5W 的输出功率
- 过温保护、短路保护
- 关断电流 < 1ua

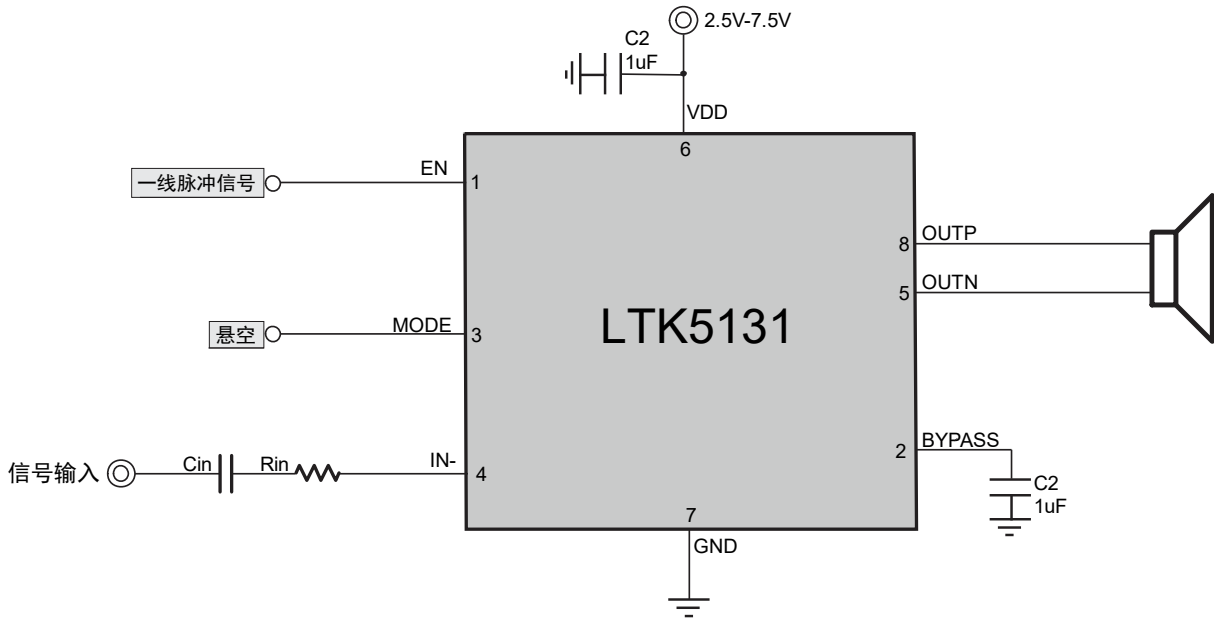
### ■ 封装

芯片型号	封装类型	封装尺寸
LTK5131	ESOP-8	

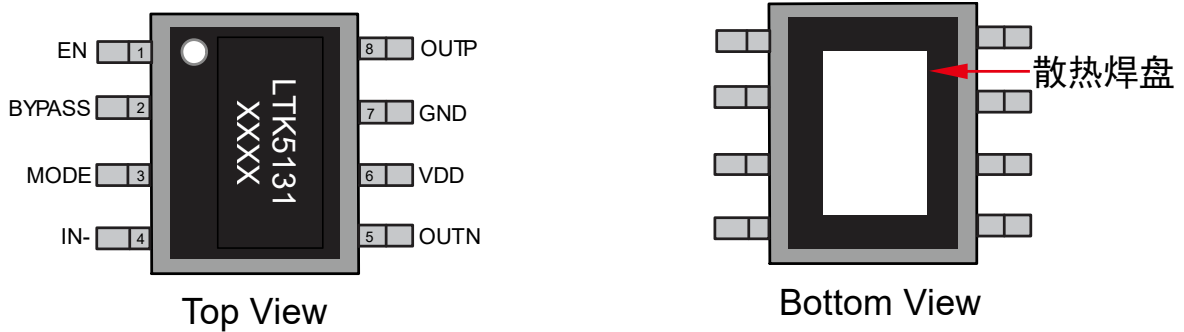
### ■ 典型应用图\_硬件控制



## ■ 典型应用图\_一线脉冲控制



## ■ 管脚说明及定义



管脚编号	管脚名称	IO	功能
1	EN	I	关断控制。高电平开启，低电平关闭。一线脉冲控制管脚
2	BYPASS	IO	内部共模参考电压，接电容下地
3	MODE	I	模式切换。高电平D类，低电平AB类.悬空默认为AB类
4	IN	I	模拟输入端，反相
5	OUTN	O	输出端负极
6	VDD	IO	电源正端
7	GND	IO	电源负端
8	OUTP	O	输出端正极

## ■ 最大极限值

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V <sub>DD</sub>	7.5V(MAX)	V
存储温度	T <sub>STG</sub>	-65°C-150°C	°C
结温度	T <sub>J</sub>	160°C	°C

## ■ 推荐工作范围

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V <sub>DD</sub>	3-7V	V
工作环境温度	T <sub>STG</sub>	-40°C to 85°C	°C
结温度	T <sub>J</sub>	-	°C

## ■ ESD 信息

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	V

## ■ 基本电气特性

A<sub>V</sub>=20dB, T<sub>A</sub>=25°C,无特殊说明的项目均是在V<sub>DD</sub>=5V,Class\_D类4Ω+33uH条件下测试:

描述	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	I <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub> =5V,D类		-	6	-	mA
		V <sub>DD</sub> =4.2V, AB类			8		mA
关断电流	I <sub>SHDN</sub>	V <sub>DD</sub> =3V to 5 V		-	<1		uA
静态底噪	V <sub>n</sub>	V <sub>DD</sub> =5V ,A <sub>V</sub> =20DB,A <sub>w</sub> ting			120		uV
D类频率	F <sub>SW</sub>	V <sub>DD</sub> =5V			470		kHz
输出失调电压	V <sub>os</sub>	V <sub>IN</sub> =0V			10		mV
启动时间	T <sub>start</sub>	V <sub>DD</sub> =5V, Bypass=1uF			150		ms
增益	A <sub>v</sub>	D类模式, R <sub>IN</sub> =22k			≈20		DB
电源关闭电压	V <sub>DDEN</sub>	EN=1			<1.7		V
电源开启电压	V <sub>DDopen</sub>	EN=1			>2.5		V
EN开启电压	EN <sub>open</sub>				>2.0		V
EN关断电压	EN <sub>sd</sub>				<0.9		V
MODE_D类电压	MODE <sub>class_D</sub>				>2.0		V
MODE_AB类电压	MODE <sub>class_AB</sub>				<0.9		V
过温保护	O <sub>TP</sub>				180		°C
静态导通电阻	R <sub>DS(on)</sub>	I <sub>DS</sub> =0.5A	P_MOSFET		150		mΩ
		V <sub>GS</sub> =4.2V	N_MOSFET		120		
内置输入电阻	R <sub>s</sub>				7.5K		kΩ
内置反馈电阻	R <sub>f</sub>				195K		kΩ
效率	η <sub>C</sub>				91		%

● **Class\_D功率**

$A_V=20\text{dB}$ ,  $T_A=25^\circ\text{C}$ ,无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5\text{V}$ , $4\Omega$ 条件下测试:

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
输出功率	$P_o$	THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$ , $R_L=2\Omega$ ;	$V_{DD}=7\text{V}$	-	11	-	W
			$V_{DD}=6\text{V}$	-	8.1	-	
			$V_{DD}=5\text{V}$		5.8		
			$V_{DD}=4.2\text{V}$		4		
		THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$ , $R_L=4\Omega$ ;	$V_{DD}=7\text{V}$	-	6.4	-	W
			$V_{DD}=6\text{V}$		4.9		
			$V_{DD}=5\text{V}$		3.3		
			$V_{DD}=4.2\text{V}$	-	2.4	-	
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=5\text{V}$ , $P_o=1.0\text{W}$ , $R_L=4\Omega$	$f=1\text{kHz}$	-	0.03	-	%

● **Class\_AB类功率**

$A_V=20\text{dB}$ ,  $T_A=25^\circ\text{C}$ ,无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5\text{V}$ , $4\Omega$ 条件下测试:

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
输出功率	$P_o$	THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$ , $R_L=4\Omega$ ;	$V_{DD}=5\text{V}$	-	3.1	-	W
			$V_{DD}=4.2\text{V}$	-	2.3	-	
静态底噪	$V_n$	$V_{DD}=5\text{V}$ , $A_V=20\text{dB}$ , $A_{w\text{ting}}$		80		$\mu\text{V}$	
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=5\text{V}$ , $P_o=1.0\text{W}$ , $R_L=4\Omega$	$f=1\text{kHz}$	-	0.08	-	%

■ **性能特性曲线**

● **特性曲线测试条件( $T_A=25^\circ\text{C}$ )**

描述	测试条件	编号
Input Amplitude VS. OutputPower	$V_{DD}=5\text{V}$ , $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$ , Class_D	图1
THD+N VS .Output Power Class_D	$V_{DD}=7\text{V}$ , $R_L=2\Omega+15\mu\text{H}$ , $A_V=20\text{dB}$ , Class_D	图2
	$V_{DD}=6\text{V}$ , $R_L=2\Omega+33\mu\text{H}$ , $A_V=20\text{dB}$ , Class_D	图3
	$V_{DD}=5\text{V}$ , $R_L=2\Omega+33\mu\text{H}$ , $A_V=20\text{dB}$ , Class_D	
	$V_{DD}=4.2\text{V}$ , $R_L=2\Omega+33\mu\text{H}$ , $A_V=20\text{dB}$ , Class_D	
	$V_{DD}=7\text{V}$ , $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$ , $A_V=20\text{dB}$ , Class_D	
	$V_{DD}=6\text{V}$ , $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$ , $A_V=20\text{dB}$ , Class_D	
	$V_{DD}=5\text{V}$ , $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$ , $A_V=20\text{dB}$ , Class_D	
	$V_{DD}=4.2\text{V}$ , $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$ , $A_V=20\text{dB}$ , Class_D	
THD+N VS. Output Power Class_AB	$V_{DD}=5\text{V}$ , $R_L=4\Omega$ , $A_V=20\text{dB}$ , Class_AB	
	$V_{DD}=4.2\text{V}$ , $R_L=4\Omega$ , $A_V=20\text{dB}$ , Class_AB	
OutputPower VS. Suppy Voltage	$R_L=2\Omega+15\mu\text{H}$ ,THD=10%,, Class_D	图5
	$R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$ ,THD=10%,THD=1%, Class_D	图6
Frequency VS.TH D+N	$V_{DD}=5\text{V}$ , $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$ , $A_V=20\text{dB}$ , $P_o=1\text{W}$ ,Class_D	图7
Frequency Response	$R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$ , Class_D	图8

● 特性曲线图

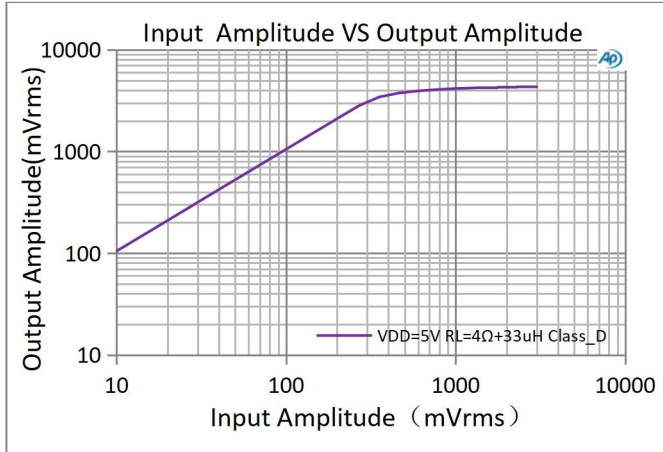


图1: Input Amplitude VS. Output Amplitude

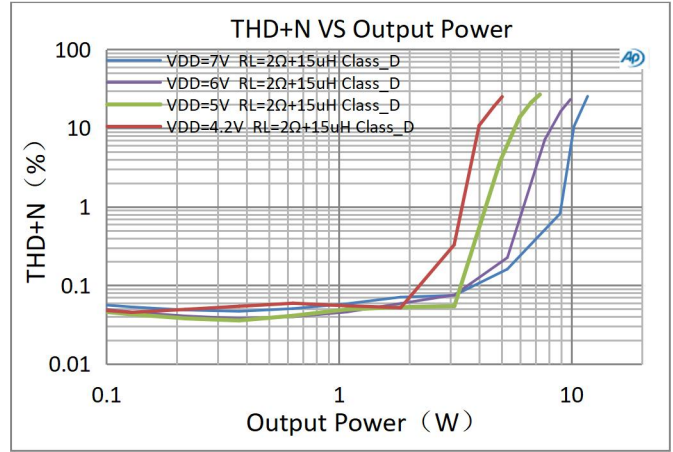


图2: THD+N VS. Output Power Class\_D

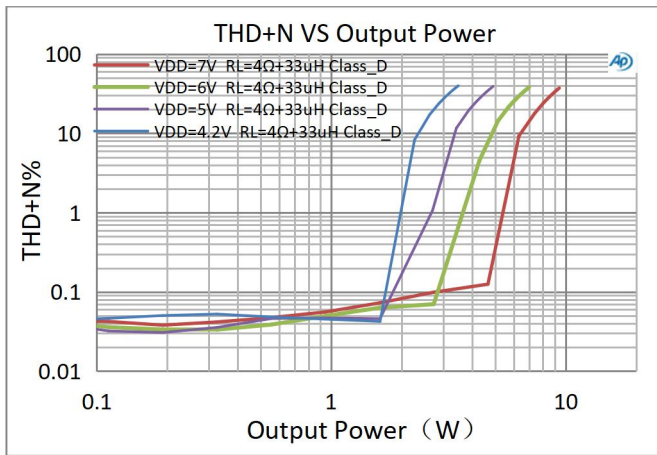


图3: THD+N VS. Output Power Class\_D

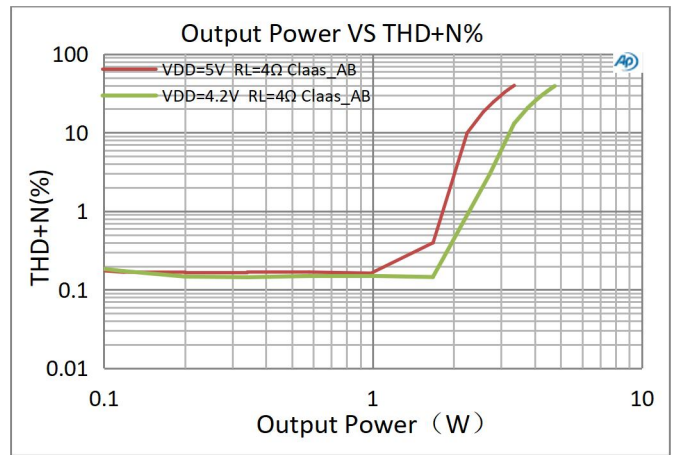


图4: THD+N VS. Output Power Class\_AB

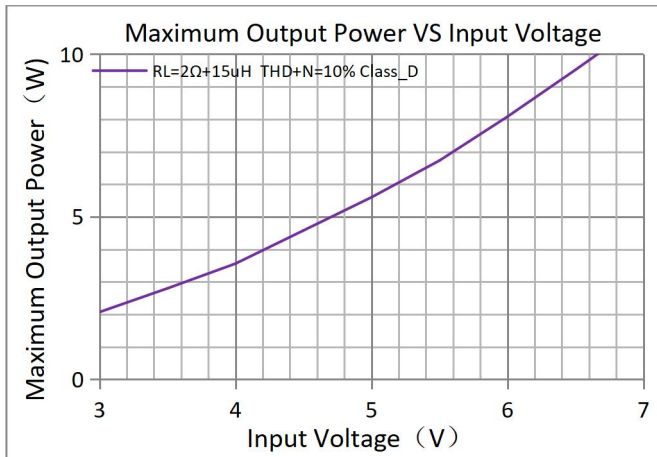


图5: OutputPower VS. Supply Voltage

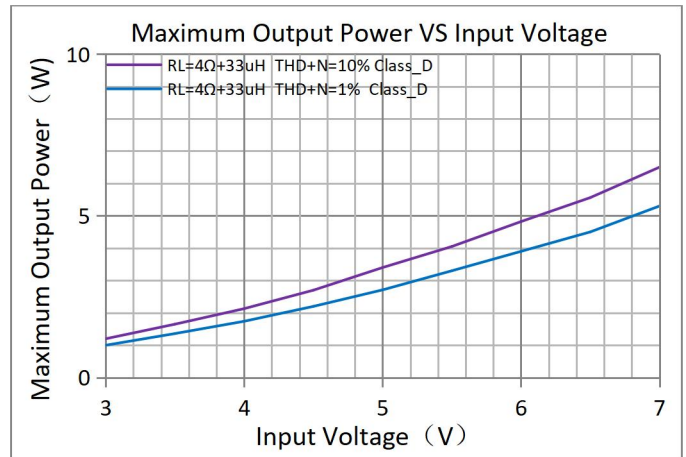


图6: OutputPower VS. Supply Voltage

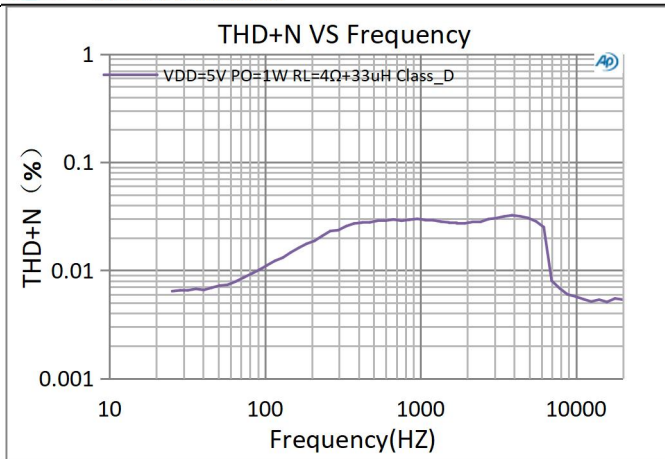


图7: Frequency VS.TH D+N

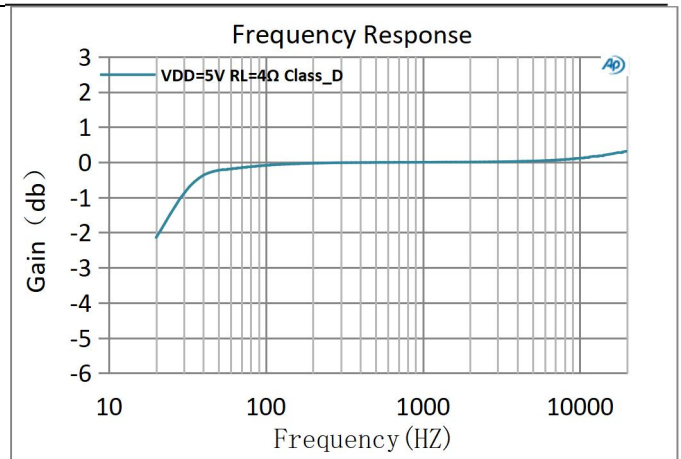


图8: Frequency Response

## 应用说明

### EN管脚控制

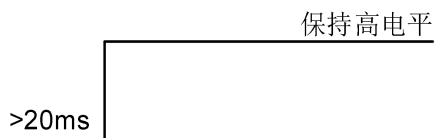
LTK5131有两种控制方式：软件控制（一线脉冲）和硬件控制（高低电平控制），一线脉冲控制的好处是可以节省主控IO，仅使用一个IO口即可切换功放多种工作模式。

EN管脚软件控制（一线脉冲）：EN管脚输入不同脉冲信号切换功放：D类防破音1

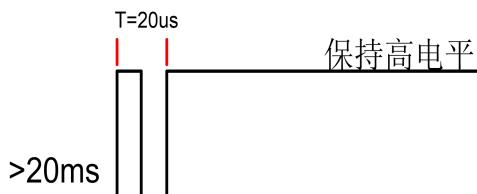
（AGC1:THD $\leq$ 1%）、D类防破音2

（AGC2:THD $\leq$ 5%）AB类和D类模式。**使用一线脉冲控制时 MODE管脚必须悬空**

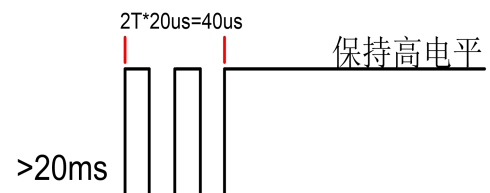
1. 芯片切换到AB类模式波形：



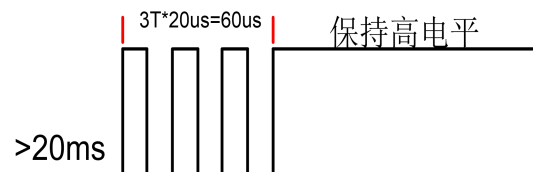
2. 芯片切换到D类防破音1模式波形（THD $\leq$ 1%）：



3. 芯片切换到D类防破音2模式波形（THD $\leq$ 5%）



4. 芯片切换到D类普通模式波形：



硬件控制（高低电平控制）：LTK5131 EN管脚为高电平时，功放芯片打开，正常工作，此时默认为防破音1模式（AGC1: THD $\leq$ 1%），EN管脚为低电平时，功放芯片关断。**（EN管脚不能悬空）**

EN管脚	芯片状态
低电平	关闭状态
高电平	打开状态

● **MODE管脚控制**

LTK5131在不使用一线脉冲控制AB/D类切换时，可以使用MODE管脚高低电平控制功放AB/D类的模式切换。建议在FM模式时切换为AB类。

MODE管脚	芯片状态
高电平	D类模式
低电平	AB类模式
悬空	AB类模式

● **功放增益控制**

D类模式时输出为（PWM信号）数字信号，AB类输出为模拟信号，其增益均可通过 $R_{IN}$ 调节。

$$A_v = 2 \times \frac{195 K\Omega}{(R_{IN} + 7.5 K\Omega)}$$

$A_v$ 为增益，通常用DB表示，上述计算结果单位为倍数、 $20\text{Log}$ 倍数=DB。

$R_{IN}$ 电阻的单位为 $K\Omega$ 、 $195K\Omega$ 为内部反馈电阻（ $R_F$ ）， $7.5K\Omega$ 为内置串联电阻（ $R_S$ ）， $R_{IN}$ 由用户根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义。如 $R_{IN}=27K$ 时，=11.3倍、 $A_v=21.06\text{DB}$   
输入电容（ $C_{IN}$ ）和输入电阻（ $R_{IN}$ ）组成高通滤，

其截止频率为：

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times (R_{IN} + 7.5K) \times C_{IN}}$$

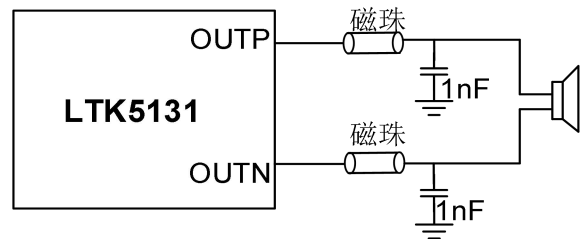
$C_{in}$ 电容选取较小值时，可以滤除从输入端耦合入的低频噪声，同时有助于减小开启时的POPO声

● **Bypass电容**

Byp电容是非常重要的，该电容的大小决定了功放芯片的开启时间，同时Byp电容的大小会影响芯片的电源抑制比、噪声、以及POP声等重要性能。建议将该电容设置为1uf,因该Byp的充电速度速度比输入信号端的充电速度越慢，POP声越小。

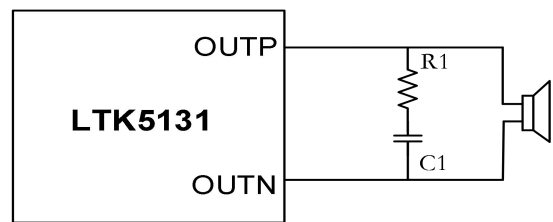
● **EMI处理**

对于输出走线较长或靠近敏感器件时，建议加上磁珠和电容，能有效减小EMI。器件靠近芯片放置



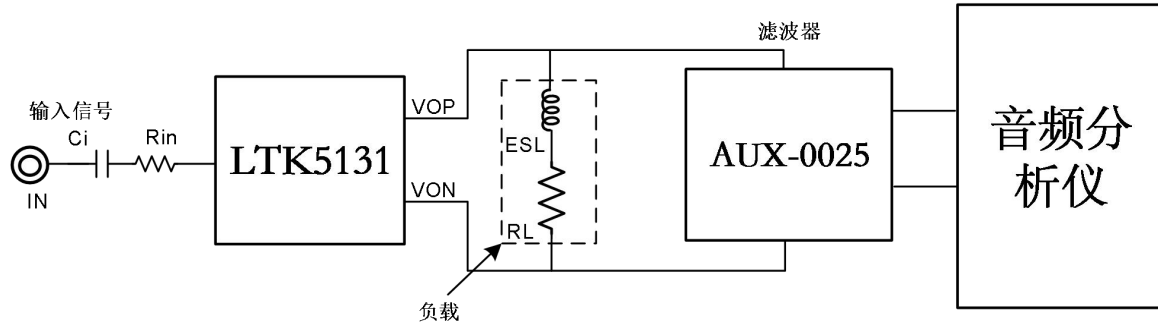
● **RC缓冲电路**

如喇叭负载阻抗值较小时，建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰，防止芯片工作异常。电阻推荐使用： $2\Omega-5\Omega$ ，电容推荐：500PF-10NF



## ■ 测试方法

在测试D类模式时必须加滤波器测试。AUX-0025为滤波器，为了测试数据精准并符合实际应用，在RL负载端串联一个电感，模拟喇叭中的寄生电感。

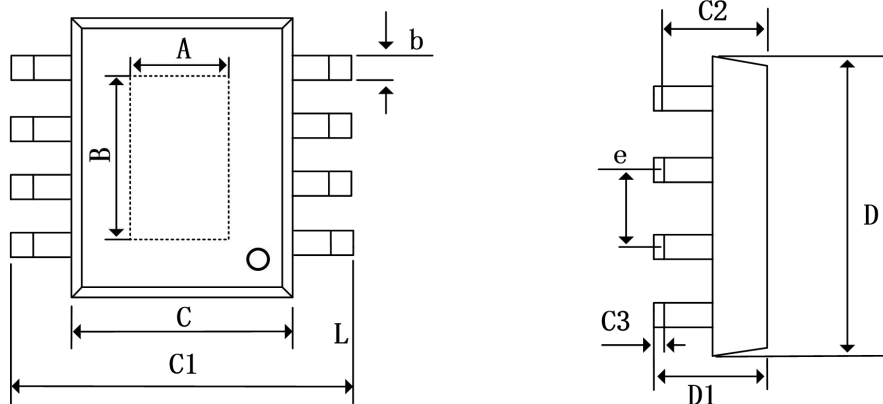


## ■ PCB设计注意事项

- 电源供电脚（VDD）走线网络中如有过孔必须使用多孔连接，并加大过孔内径，不可使用单个过孔直接连接，电源电容尽量靠近管脚放置。
- 输入电容（Cin）、输入电阻（Rin）尽量靠近功放芯片管脚放置，走线最好使用包地方式，可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。
- LTK5131 的底部散热片建议焊接在 PCB 板上，用于芯片散热，建议 PCB 使用大面积敷铜来连接芯片中间的散热片，并有一定范围的露铜，帮助芯片散热。
- LTK5131 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短，并且走线宽度需在 0.4mm 以上。



■ 芯片封装 ESOP-8



ESOP-8

字符	Dimensions In Millimeters			Dimensions In Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
<b>A</b>	2.31	2.40	2.51	0.091	0.094	0.098
<b>B</b>	3.20	3.30	3.40	0.126	0.129	0.132
<b>b</b>	0.33	0.42	0.51	0.013	0.017	0.020
<b>C</b>	3.8	3.90	4.00	0.150	0.154	0.157
<b>C1</b>	5.8	6.00	6.2	0.228	0.235	0.244
<b>C2</b>	1.35	1.45	1.55	0.053	0.058	0.061
<b>C3</b>	0.05	0.12	0.15	0.004	0.007	0.010
<b>D</b>	4.70	5.00	5.1	0.185	0.190	0.200
<b>D1</b>	1.35	1.60	1.75	0.053	0.06	0.069
<b>e</b>	1.270(BSC)			0.050(BSC)		
<b>L</b>	0.400	0.83	1.27	0.016	0.035	0.050

声明：深圳市思泽远电子有限公司保留在任何时间、不另行通知的情况下对规格书的更改权。  
深圳市思泽远电子有限公司提醒：请务必严格应用建议和推荐工作条件使用。如超出推荐工作条件以及不按应用建议使用，本公司不保证产品后续的任何售后问题。